

Dk 3.60 Df 0.0045 @13GHz
熱伝導率 0.60W/m-K
Tg(DMA) 245°C

用途
ワイヤレス通信/オートモーティブ
 パワーアンプ基板(無線通信基地局、スモールセル)、アンテナ(車載ミリ波レーダ、基地局) など



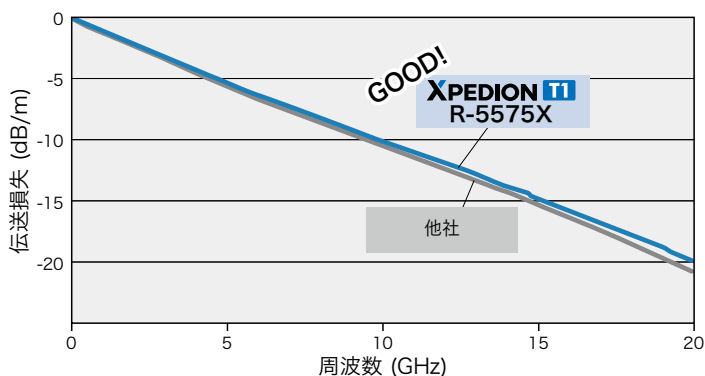
XPEDION T1

Laminate Prepreg
R-5575X R-5470X

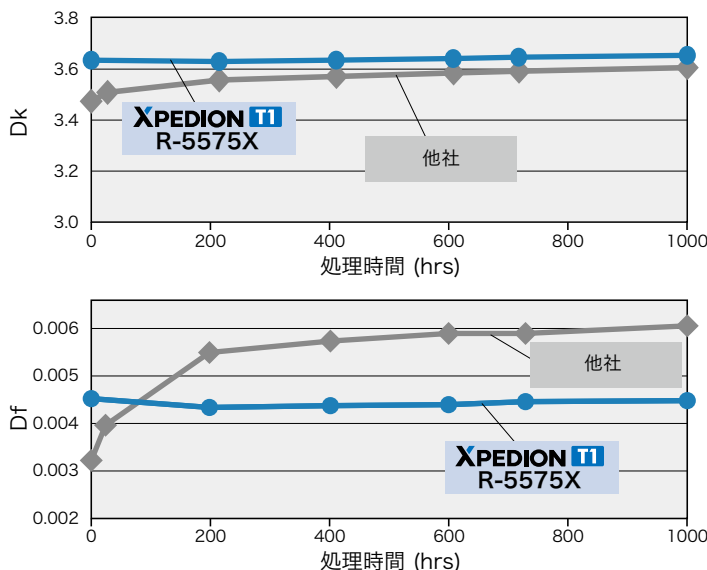
**高熱伝導率・
 低伝送損失ハロゲンフリー多層基板材料**

ハロゲンフリー、低伝送損失、高熱伝導性を兼ね備え、多層成型性で“5G”における基地局の小型化や安定稼働に貢献

伝送損失比較

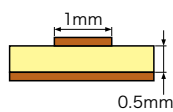


高温環境下における長期安定性 (Dk, Df)



構成

マイクロストリップライン



項目	R-5575X	他社
配線長さ	1000mm	1000mm
インピーダンス	50±1Ω	50±1Ω
銅箔厚さ	18μm→+20μm plating	18μm→+20μm plating
銅箔	RT	ST
コア材	0.5mm	0.5mm

- ・試験方法：平衡型円板共振器法
- ・エイジング温度：125°C (湿度制御なし)
- ・試験周波数：18GHz

一般特性

項目	試験方法	条件	単位	XPEDION T1 R-5575X	他社	
ガラス転移温度(Tg)	DMA	A	°C	245	Tg less	
熱膨張係数(厚さ方向)	α1/α2	IPC-TM-650 2.4.24	ppm/°C	20/155	21/42	
T288(銅付)	IPC-TM-650 2.4.24.1	A	分	>120	>120	
熱伝導率	レーザーフラッシュ法	A	W/m-K	0.6	0.6	
比誘電率(Dk)	13GHz 平衡型円板共振器法	C-24/23/50	-	3.60	3.5	
誘電正接(Df)				0.0045	0.004	
銅箔引き剥がし強さ*	1oz(35μm)	IPC-TM-650 2.4.8	A	kN/m	0.80	0.58

試験片の厚さは0.5mmです。

※ RT銅箔

商品のご採用にあたっては、当社webサイトより注意事項をご確認ください。

当社ハロゲンフリー材料は、JPCA-ES-01-2003などの定義によるものです。

上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。